

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



1 EURIC HERREN IN BUREN HER BOOK ONDE KOM DE REKEN EEN EEN EKEN DE REKEN DE BOOK DE KOM DE REKEN DE FERSTE HER

(43) 国際公開日 2005 年4 月21 日 (21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/036630 A1

(51) 国際特許分類⁷: 21/3065, C08G 77/52, C09D 183/14 H01L 21/312,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/013125

(22) 国際出願日:

2004年9月9日(09.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-352219

2003年10月10日(10.10.2003) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): AZ エレクトロニックマテリアルズ株式会社 (AZ ELECTRONIC MATERIALS (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京 グリーンコート Tokyo (JP).

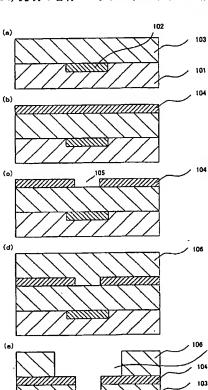
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田代 裕治 (TASHIRO, Yuji) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県小笠郡大東町千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Shizuoka (JP). 青木 宏幸 (AOKI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1138662 東京都文京区本駒込 2 丁目28番8 号 文京グリーンコート AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP). 石川 智規 (ISHIKAWA, Tomonori) [JP/JP]; 〒1138662 東京都文京区本駒込 2 丁目28番8号 文京グリーンコート AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 吉武賢次、外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒 1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号富士 ビル323号協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

/続葉有/

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING ETCHING STOPPER LAYER

107

(54) 発明の名称: エッチングストッパー層形成用組成物



WO 2005/036630 A1 III

- (57) Abstract: Disclosed is a composition for forming an etching stopper layer which has dry etching selectivity ratio and low dielectric constant at the same time. Also disclosed is a method for manufacturing a semiconductor device wherein such a composition is used. Specifically, a composition for forming an etching stopper layer including a silicon-containing polymer is characterized in that the silicon-containing polymer included in the composition has a disilylbenzene structure. Also disclosed is a method for manufacturing a semiconductor device wherein an etching stopper layer is formed using such a composition.
- (57) 要約: ドライエッチング選択比と低誘電率とを両立したエッチングストッパー層を形成するための組成物、およびそれを用いた半導体装置の製造法の提供を目的とする。この目的は、ケイ素含有ポリマーを含んでなるエッチングストッパー層形成用組成物であって、組成物に含有されるケイ素含有ポリマーがジシリルベンゼン構造を含んでいるエッチングストッパー層形成用組成物、およびそれを用いてエッチングストッパー層を形成させる半導体装置の製造法により解決される。



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, のガイダンスノート」を参照。

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語